# <sup>®</sup> 公 開 特 許 公 報 (A) 平4-42519

Int. Cl.	識別配号	庁内整理番号	<b>@</b> 公開	平成 4 年(1992)	2月13日
H 01 G 9/04 C 25 D 11/16 H 01 G 9/04	3 3 7 3 0 2 3 0 1	7924-5E 7179-4K 7924-5E			
•		審査請求	未請求 謂	青求項の数 2 (	全6頁)

**図発明の名称** アルミニウム電解コンデンサの電極およびその製造方法

②特 願 平2-151171

❷出 願 平2(1990)6月8日

@発 明 努 老 南 大阪府大阪狭山市大野台2-7-1 @発 明 者 峠 登 奈良県大和郡山市小泉町547-12 @発 明 者 志 目 将 大阪府大阪市中央区久太郎町3丁目6番8号・東洋アルミ ニウム株式会社内 個発 明 者 清 水 遵 大阪府大阪市中央区久太郎町3丁目6番8号 東洋アルミ ニウム株式会社内 创出 願人 東洋アルミニウム株式 大阪府大阪市中央区久太郎町3丁目6番8号 会社

⑫代 理 人 弁理士 三枝 英二 外2名

## 明細書

発明の名称 アルミニウム電解コンデンサの電極 およびその製造方法

#### 特許請求の範囲

ム電解コンデンサの電極。

①エッチングしたアルミニウム箔の表面に TiO2 およびTa2 O5 から選ばれた少なくとも一種の酸化物からなる耐電圧性に優れた高誘電酸化皮膜が陽極酸化皮膜(A22 O3層)を介して設けられており、該陽極酸化皮膜の厚さが高誘電酸化皮膜と陽極酸化皮膜との合計厚さの10~90%の範囲にあることを特徴とするアルミニウ

②エッチングしたアルミニウム箔をTiおよび Taの少なくとも一種を含むアルコキシドの有機 溶剤溶液により漏らし、200~400℃で乾燥し、次いで500~650℃で焼成した後、陽極酸化することを特徴とするアルミニウム電解コンデンサの電極の製造方法。

# 発明の詳細な説明

## 産業上の利用分野

本発明は、アルミニウム電解コンデンサの電極およびその製造方法に関する。

# 従来技術とその問題点

アルミニウム電解コンデンサの電極は、化学的 或いは電気化学的エッチングによりアルミニウム 箔表面に複雑なエッチピット構造を効率良く形成 させた後、陽極酸化(化成)によりその表面に A ℓ 2 O 3 からなる誘電酸化皮膜を形成させるこ とにより、製造されている。

しかしながら、A ℓ 2 O 3 は、耐電圧が約15 入 / V と優秀な絶縁体ではあるものの、比誘電率 が約8~10と比較的低いために、A ℓ 2 O 3 か らなる皮膜の形成では、静電容量の増大には、限 界がある。従って、エッチドアルミニウム箔の表 面に、T i O 2 、T a 2 O 5 、N b 2 O 5 、 B a T i O 3 などの高誘電性膜を形成する技術が 種々提案されている。

例えば、特開昭63-306614号公報には、 アルミニウム箔の表面にTiをイオンプレーティ ングした後、陽極酸化して、All-Ti混在酸化 物の誘電酸化皮膜を形成する方法が開示されてい る。また、特開昭63-304613号公報には、 アルミニウム箔の表面にBaTiO。を溶射した 後、陽極酸化して、複合誘電酸化皮膜を形成する 方法が開示されている。しかしながら、これらの 方法では、複雑なエッチピット構造のアルミニウ ム箔のピット内部に至るまで高誘電酸化皮膜を均 一に形成することは、出来ない。

特開昭60-60709号公報には、陽極酸化 したアルミニウム箔にチタンエトキシドの様な金 属アルコキシドの有機溶剤溶液を浸漬塗布し、加 熱処理して、複合誘電酸化皮膜を形成する方法が 開示されている。また、特開昭55-69291 号公報には、アルミニウム箔にチタンプトキシド

浸漬塗布し、アルコキシドを加水分解し、次いで 陽極酸化処理を行なうに際し、加熱を一段階で行 なうのではなく、特定条件下に二段階で行なう場 合には、高密度で欠陥の少ない複層の金属酸化物 層が形成されることを見出した。

すなわち、本発明は、下記のアルミニウム電解 コンデンサの電極およびその製造方法を提供する ものである:

①エッチングしたアルミニウム箔の表面に TiO2 およびTa2 O, から選ばれた少なくと も一種の酸化物からなる耐電圧性に優れた高誘電 酸化皮膜が陽極酸化皮膜(Al203層)を介し て設けられており、該陽極酸化皮膜の厚さが髙誘 電酸化皮膜と陽極酸化皮膜との合計厚さの10~ 90%の範囲にあることを特徴とするアルミニウ ム電解コンデンサの電極。

②エッチングしたアルミニウム箔をTiおよび Taの少なくとも一種を含むアルコキシドの有機 の様な金属アルコキシドの有機溶剤溶液を浸渍塗 布し、これを水中で煮沸することにより、金属ア ルコキシドを加水分解させ、加熱後、陽極酸化し て、TiO2層を形成させる方法が開示されてい る。さらに、特開平2-65219号公報には、 エッチングしたアルミニウム箔にジメチルアンモ ニウムチタネート水溶液を浸漬塗布し、加熱後、 陽極酸化して、TiOュ層を形成させる方法が開 示されている。しかしながら、これらの方法では、 いずれもアルミニウム箔上に高密度で欠陥の少な いTiO₂層を形成させることが難しいので、耐 電圧性の全てもしくは殆どをAQ2〇3層に依存 することになり、結局静電容量の増大はあまり期 待できない。

# 問題点を解決するための手段

・ 本発明者は、上記の如き技術の現状に鑑みて種 々研究を重ねた結果、エッチングしたアルミニウ ム箔に特定金属のアルコキシドの有機溶剤溶液を、

溶剤溶液により濡らし、200~400℃で乾燥 し、500~650℃で焼成した後、陽極酸化す ることを特徴とするアルミニウム電解コンデンサ の電極の製造方法。

本発明で使用するアルミニウム箔は、純度。 99. 9~99. 99%の範囲内にあることが好 ましい。

本発明方法は、通常以下の様にして実施される。 まず、アルミニウム箔を電解エッチングする。エ ッチングは、常法に従って、HC1系、NaC1 系などのエッチング液を使用して行なえば良く、 エッチング条件などは、特に限定されない。

次いで、エッチングを終えたアルミニウム箔の 表面には、金属アルコキシドの有機溶剤溶液が塗 布乃至付与される。金属アルコキシドとしては、 Ti (i - OC 3 H 7 ) 4 \

 $T i (n - OC_4 H_0)_4$ 

Ta (i - OC 3 H 7 ) 5 \

Ta(OC2 H5);などが例示される。また、 有機溶剤としては、エタノール、イソプロパノー ル、n-プタノールなどのアルコール類;ベンゼ ン、トルエン、キシレンなどの芳香族炭化水素類; ナフサなどが例示される。有機溶剤溶液中の金属 アルコキシドの濃度は、通常O.O2~1M程度 であり、より好ましくは、0.1~0.5 M程度 である。また、有機溶剤溶液には、加水分解のた めに、金属アルコキシドに対し、水2倍当量程度、 を加えておく。また、アセチルアセトン、トリエ タノールアミン、ジエタノールアミンなどの加水 分解を遅らせる有機物を添加しても良い。エッチ ングされたアルミニウム箔表面に対する金属アル コキシドの有機溶剤溶液の付与は、浸漬法、スピ ンコート法、スプレイコート法などの任意の方法 で行なうことができる。有機溶剤溶液の付与に際 しては、加水分解を防止するために、雰囲気湿度 を40%以下に保持し、且つ温度を25℃以下に

次いで、上記の様にして乾燥されたアルミニウ ム箔を500~650℃程度で10~120分間 程度焼成することにより、Aℓ₂Ο,と同程度の 優れた耐電圧性(約25Å/V乃至約12Å/V 程度)を有する高誘電酸化皮膜を形成することが できる。焼成により形成されるアルミニウム箔上 に形成される皮膜は、高密度であり、ピットの内 部にいたるまで均一にコートする欠陥の非常に少 ない高誘電酸化皮膜である。チタンアルコキシド を使用する場合に形成される高誘電酸化皮膜は、 アナターゼ型TiOzからなっている。焼成温度 が500500℃未満の場合には、結晶化が十分 でなく、低密度の酸化皮膜が形成され、耐電圧性 を有する高誘電酸化皮膜は得られない。また、前 記の乾燥を200℃未満で行ない、次いで焼成を 500~650℃の範囲で行なう場合には、

TiO2および/またはTa2O,層が大きな熱収縮応力を受けるので、欠陥の多い酸化皮膜が形

維持することが望ましい。

次いで、表面に金属アルコキシドの有機溶剤溶 液を付与されたアルミニウム箔は、そのまま或い は室温乾燥後に通常200~400℃で1~ 120分間程度乾燥処理される。この乾燥段階で、 有機溶剤が完全に分解除去され、且つ金属アルコ キシドが部分的に加水分解されて、その有機物成 分の脱離が促進される。乾燥温度が200℃未満 の場合には、有機物の除去が十分に行なわれない ので、次の焼成時に酸化物層に欠陥を発生させる 原因となる。一方、乾燥温度が400℃を上回る 場合には、金属アルコキシド塗布層の急速な収縮 により、欠陥を生ずる場合があり、また、熱エネ ルギーの損失が大きくなるので、不利である。 TiO2 および/またはTa2 O5 層の厚さを必ご 要に応じて増大させるためには、アルミニウム箔: に対する金属アルコキシド有機溶剤溶液の付与お よび乾燥を必要回数だけ繰返して行えば良い。

成され、やはり耐電圧性を有する髙誘電酸化皮膜は得られない。さらに、焼成温度が650℃を上回る場合には、変形が起こり始めるので、好ましくない。

次いで、上記の様にしてTiO2およこのは はTa2Os 皮膜を形成されたアルミニウム にはTa2Os 皮膜を形成されたアルミニウム に成り処理される。陽極酸化(の電解条件などは、常法におけるものもの で良い。この化成処理により、アルウルミニウの間 とTiO2および/またはTa2Os 層)が形成しては、 る。化成に際しては、ないとこのが、 TiO2および/またはTa2Os 皮膜 には で良いななない。 で良っては Ta2Os 皮膜 には でしていたない。 で良ったは Ta2Os 皮膜 でしていまたは Ta2Os 皮膜 でしていまたは Ta2Os 皮膜 する酸素が A Q2Os 層の形成 が可能となるものと推測される。本発明の を解かるものと推測される。 が可能となるものと とでに とてに に応じて、 高誘電を に応じて、 この電圧の

機能を発揮し、また、高誘電酸化皮膜内の欠陥を さらに減少させる。すなわち、化成による体積膨 限により、内壁の皮膜はピットの中心方向へと押 し込められ、残存する亀裂などの欠陥が修復され る。

本発明の電解コンデンサの電極における AllOs層の厚さは、TiOsおよび/または Ta<sub>2</sub>O<sub>5</sub>層とAl<sub>2</sub>O<sub>3</sub>層との合計厚さの1O ~90%程度、より好ましくは10~70%程度、 特に好ましくは10~50%程度とする。

静電容量は、高誘電酸化皮膜と陽極酸化皮膜と の合成容量と見なすことができるので、電極の表 面積をS、高誘電酸化皮膜の厚さおよび比誘電率 をそれぞれ d н および е н とし、陽極酸化皮膜の 厚さおよび比誘電率をそれぞれdヒおよびεレと すると、静電容量では、下式により表わされる。

 $C = S / (d_H / \epsilon_H + d_L / \epsilon_L)$ ここで、S、 $d_H + d_L$ 、 $\epsilon_H$  および $\epsilon_L$ 

される。

- (1) 金属アルコキシド法により形成された薄膜 を特定条件下に2段階で加熱処理するので、複雑 なエッチピット構造を有するアルミニウム箔表面 に高密度で、欠陥の少ない高誘電率酸化皮膜を均 一に形成することが出来る。
- (2) 金属アルコキシド法により形成された薄膜 を乾燥後、500~650℃という高温で焼成す るので、アルミナと同程度の優れた耐電圧性を有 する高誘電酸化皮膜が得られる。
- (3) 焼成後に行なう陽極酸化処理により、高誘 電酸化皮膜の欠陥が修復される。
- (4) 陽極酸化皮膜の厚さを小さくすることがで きるので、静電容量を顕著に増大させることがで きる。
- (5) 陽極酸化皮膜の厚さを調整することにより、 各種の用途に応じて広範囲の使用電圧に対応する ことができる。

 $(e_R > e_L)$ を一定とすると、静電容量Cは、 d H および d L 、特に d L を小さくする程、即ち、 d L / (d H + d L ) 値を小さくする程、増大す ることが明らかである。また、上記の式から、本 発明によれば、低圧から高圧にいたる使用電圧に 応じて適切な d L / (d n + d L ) 値を選択する ことにより、静電容量を任意に増大することがで きることが明らかである。高誘電酸化皮膜と陽極 酸化皮膜との合計厚さ(dェ+dェ)に占める陽 極酸化皮膜(d1)の割合が、10%未満の場合 には、使用電圧を制御し得る範囲が狭くなり、ま た高誘電酸化皮膜を修復する効果が失われる。一 方、この割合が、90%を上回る場合には、比誘 電率の低いAℓ₂Ο₃層が酸化皮膜の殆どを占め ることになり、従来のアルミニウム電解コンデン サと大差のないものとなる。

#### 発明の効果

本発明によれば、下記の様な顕著な効果が達成

# 実 施 例

以下に実施例および比較例を示し、本発明の特 徴とするところをより一層明確にする。

## 実施例1

C<sub>2</sub> H<sub>5</sub> O H

厚さ100μmの99.99%A ℓ 箔を塩酸水 溶液中で電解エッチングして租面化した後、下記 の組成(モル比)の溶液に3秒間浸漬した。その 際の湿度は、40%以下とした。

 $T i (n - O C_4 H_9)_4$ 0.15

CH3 COCH2 COCH3 0.45

18

H<sub>2</sub> O 0.3

浸漬処理後のAQ箔を自然乾燥させた後、空気 中300℃で1時間乾燥して、溶媒を完全に除去 した。

上記の溶液浸漬および乾燥をさらに3回繰返し て、A ℓ 箔上に厚さO. 15 μ m の T i O 2 層を 形成した後、所定の温度で1時間焼成した。

次いで、5%硼酸水溶液中で150Vの陽極酸 化を行ない、A ℓ 箔とT i O 2 層との間に A ℓ 2 O 3 層を形成させた。

第1表に焼成温度と焼成製品の特性との関係を 示す。

第 1 表

使成温度	d L / d H + d L	Ti0 2 層の耐電圧
<u>(°C)</u>	(%)	(Å/V)
500	3 5	1 6
600	25.	1 2
650	2 3	1 2
300	5 0	4 3
400	4 4	2 6
_	100	

注1) d H および d L は、それぞれ試料断面の透 過電子顕微鏡写真から測定した誘電酸化皮 膜および陽極酸化皮膜の厚さ (μm)を示

# 実施例2

TiO2層形成後のA ℓ 箔の化成を300 Vで行なう以外は実施例1と同様にして、A ℓ 箔の処理を行なった。

結果を第2表に示す。

第 2 表

<u> 姚成温度</u>	7 4 8 <b>1</b>	<b>通报电波</b>	d <u>г / dн + dг</u>
<u>(°C)</u>	(#F/5d)	(A/5ai)	(%)
500	6.29	0.03	6 5
800	6.51	0.04	6 4
850	6.85	0.04	6 1
300	5.24	0.02	7 1
400	5.54	0.03	7 0
_	4.38	0.01	100

#### 実施例3

下記組成(モル比)の浸漬液を使用してA Q 箔上に厚さ O. 2 5 μ m の T i O 2 層を形成させる

す。

注 2 ) T i O 2 層の耐電圧は、陽極酸化皮膜の耐 電圧を 1 3 Å / V として、 d : および d : から算出した。

また、陽極酸化後のA ℓ 箔の断面を透過電子顕微鏡により観察したところ、500~650℃で焼成したものは、いずれも十分な厚さの欠陥の少ない T i O 2 層の耐電圧層を有し、この T i O 2 層が形成されていた。これに対し、300~400℃で焼成したものでは、 T i O 2 層を形成しない場合と同程度の厚い A ℓ 2 O 3 層が形成されていることが判明した。 さらに 数回折の結果、 500~650℃ 成成した場合には、アナターゼ型 T i O 2 が形成され、300~400℃ 焼成した場合には、無

とともに、化成を300Vで行なう以外は実施例 1と同様にして、AV箔の処理を行なった。

定型のTiO₂が形成されていることが確認され

Ti (n-OC<sub>4</sub> H<sub>9</sub>)<sub>4</sub> 0. 15 CH<sub>3</sub> COCH<sub>2</sub> COCH<sub>3</sub> 0. 45 C<sub>2</sub> H<sub>3</sub> OH 9

0.3

結果を第3表に示す。

H<sub>2</sub>O

第 3 表

模成温度	<b>5 8 8 1</b>	RATE	$d_L / d_H + d_L$
<u>(7)</u>	(µF/5d)	(A/5d)	(%)
500	8.07	0.04	4 2
600	8.63	0.05	3 7
650	8.95	0.05	3 6
300	5.78	0.03	5 8
400	6.21	0.04	54
	4.38	0.01	100

実施例4

浸漬液の成分としてTi(n-OC4 H,)4 に代えてTa(OC2 H,),を使用する以外は 実施例1と同様にして、A Q 箔の処理を行なった。 結果を第4表に示す。

#### 第 4. 表

美成温度	1 8 8 1	<b>新 其 其 法</b>	_d <u> </u>
<u>(7)</u>	(#F/5al)	$(\Lambda/5d)$	(%)
500	15.3	0.02	3 2
600	18.6	0.02	2 3
650	17.9	0.02	2 3
300	10.0	0.01	5 1
400	10.5	0.01	4 9
	9.7	0.01	100

(以上)

代理人 弁理士 三 枝 英 二